

氮化镓晶片生产厂家 4英寸自支撑氮化镓衬生产商

产品名称	氮化镓晶片生产厂家 4英寸自支撑氮化镓衬生产商
公司名称	苏州恒迈瑞材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒迈瑞 型号:4英寸 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路60号（蠡盛大厦）507室（注册地址）
联系电话	15366208370

产品详情

氮化镓晶片生产厂家 4英寸自支撑氮化镓衬底生产商

恒迈瑞公司目前自支撑氮化镓晶片有2英寸和方形10*10.5mm²氮化镓衬底，实现了氮化镓单晶材料生长的n型掺杂、补偿掺杂，研制出高电导率的和半绝缘的氮化镓单晶。蓝宝石氮化镓衬底有2英寸和4英寸，衬底结构为GaN on Sapphire。

氮化镓自支撑衬底尺寸：2inch 50.8mm ± 1mm 氮化镓自支撑衬底厚度：350um/400um 晶向：C-plane(0001)
M Axis 0.35 ° ± 0.15 ° 掺杂类型：N型非掺杂/N型硅掺杂/半绝缘型铁掺杂 TTV: 15um
BOW: 20um 包装：晶圆盒或cassette盒 Ga面粗糙度：< 0.2nm polished < 0.3nm Epi ready polished

GaN是第三代半导体材料，相比于一代的硅（Si）以及第二代的砷化镓（GaAs）等，它具备比较突出的优势特性。由于禁带宽度大、导热率高，GaN器件可在200 以上的高温下工作，能够承载更高的能量密度，可靠性更高；较大禁带宽度和绝缘破坏电场，使得器件导通电阻减少，有利与提升器件整体的能效；电子饱和速度快，以及较高的载流子迁移率，可让器件高速地工作。利用GaN人们可以获得具有更大带宽、更高放大器增益、更高能效、尺寸更小的半导体器件。